PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-043903

(43) Date of publication of application: 17.02.1998

(51)Int.CI.

B23B 1/00

B23B 27/00

B23B 27/20

(21)Application number: 08-200559

(71)Applicant : SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(22)Date of filing:

30.07.1996

(72)Inventor: FUSE TAKASHI

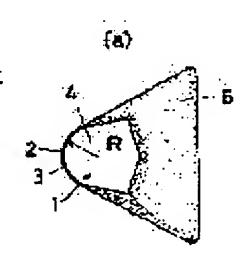
KYOTANI TATSUYA

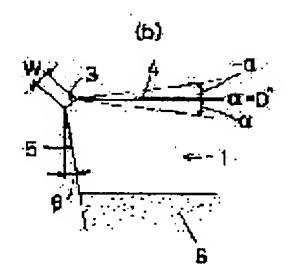
(54) SUPER PRECISION CUTTING METHOD FOR CRYSTAL MATERIAL

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To inexpensively perform surface work of a ZnSe lens with high accuracy and with high quality.

SOLUTION: Surface work is performed up to finishing work from rough work by a single cutting tool by using a monocrystal diamond cutting tool on which a rake angle α is set to (-) 20 to 20 degrees and a relief angle βis set to 5 to 10 degrees and a cutting edge is chamfered in a width of W=0.5 to $2\mu m$. In the rough work, a notch quantity is set to 5 to 10 μ m, and in the finishing work, a notch quantity is set to 1 to 5 µm, and plural crystal materials are continuously worked by the same single cutting tool.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.07.1999

[Date of sending the examiner's decision of

05.03.2002

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3544601

[Date of registration]

16.04.2004

[Number of appeal against examiner's decision

2002-05523

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

02.04.2002

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-43903

(43) 公開日 平成10年(1998) 2月17日

大阪市此花区島屋一丁目1番3号 住友電

大阪市此花区島屋一丁目1番3号 住友電

気工業株式会社大阪製作所内

気工業株式会社大阪製作所内

(74)代理人 弁理士 鎌田 文二 (外2名)

(72)発明者 京谷 達也

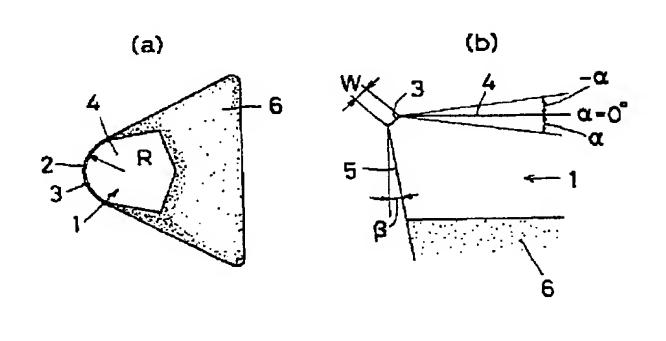
(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
B 2 3 B 1/0	00		B 2 3 B	1/00 Z
27/0	00		2	27/00 A
27/2	20		2	27/20
			審査請求	未請求 請求項の数1 OL (全 4 頁)
(21) 出願番号 特願平8-200559			(71)出願人	000002130 住友氧気工業株式会社
(22)出顧日	平成8年(1996)7	月30日	(72)発明者	大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

(54)【発明の名称】 結晶材料の超精密切削加工方法

(57)【要約】

【課題】 ZnSeレンズなどの表面加工を、高精度、 髙品質に低コストで行えるようにすることである。

【解決手段】 すくい角 α が-20~20度、逃げ角 β が5~10度で、切刃エッジがW=0. 5~2μmの幅 で面取りされている単結晶ダイヤモンドバイトを用いて 1本のバイトで粗加工から仕上げ加工までを行う。粗加 工は切込み量を5~10μm、仕上げ加工は切込み量を $1 \sim 5 \mu m$ とし、また、同じ1本のバイトで複数個の結 晶材料を連続的に加工する。



I

【特許請求の範囲】

*【請求項1】 加工工具として、すくい角が-20~2 0度、逃げ角が5~10度に設定され、かつ切刃エッジ が O. 5~2 μ m の幅で面取りされている単結晶ダイヤ モンドバイトを用い、そのバイトの送りを反復させて粗 加工から仕上げ加工までを1本のバイトで実施し、粗加 工での切込み量は5~10μm、仕上加工での切込み量 は1~5μmとし、さらに、その1本のバイトで2個以 上の結晶材料を同一加工プログラムに基いて連続的に加 工することを特徴とする結晶材料の超精密切削加工方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、結晶材料の超精 密切削加工方法、特に、レーザ用光学部品として用いら れるZnSeレンズなどの表面加工を、髙精度、髙品質 に低コストで行うための方法に関する。

[0002]

【従来の技術】レーザ加工装置に用いるZnSeのレン ズ等は、35度~45度の負のすくい角を有する単結晶 ダイヤモンドバイトを用いて表面を超精密切削加工(si ngle-point diamond turning. 通称SPDT加工)する 方法で作られている。

【0003】SPDT加工は、非球面加工が可能で加工 時間も短く、また、多品質対応、高精度確保などの点で 研磨加工よりも優れる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】SPDT加工に用いら れる従来の単結晶ダイヤモンドバイトは、図3に示すよ うに、切刃2の刃先が非常に鋭利になっている。この鋭 *30* 【0013】以上の工夫で、切込みを大きくした加工、 利な刃先は、単結晶ダイヤモンド1自体が小さくて脆い こともあって欠損し易く、バイトの寿命が短い。従っ て、このようなバイトを用いる従来法では、加工面積の 大きい大径部品の加工が困難である。また、粗加工→中 仕上げ(これは必要に応じて行われる)→仕上げの各段 階でバイト交換を必要とし、工具費、交換時間(1~2 時間/回)が多くなって加工費が嵩む。

【0005】また、刃先保護のために1回の切込み量を 大きくできず、1μm以下の微小切込みによる切削を繰 現象も不安定になる。加工現象が安定していないと表面 粗さが粗くなり、くもりも発生して部品の光学特性が悪 くなる。レーザ加工装置は、光学部品の特性によって性 能が左右されるので、髙精度、髙品質の光学部品を必要 とし、この点において従来のSPDT加工は適性に欠け るものであった。

【0006】この発明は、ZnSe等のSPDT加工に おける前述の諸問題を解消することを課題としている。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた 50 ザ加工装置は、光学部品の高い品質と優れた光学特性に

め、この発明においては、加工工具として、すくい角が - 20~20度、逃げ角が5~10度に設定され、かつ 切刃エッジが 0. 5~2μmの幅で面取りされている単 結晶ダイヤモンドバイトを用いる。また、そのバイトの 送りを反復させて粗加工から仕上げ加工までを1本のバ イトで実施する。さらに、粗加工での切込み量は5~1 $0 \mu m$ 、仕上加工での切込み量は $1 \sim 5 \mu m$ とし、さら に、その1本のバイトで2個以上の結晶材料を同一加工 プログラムに基いて連続的に加工する。

2

【0008】かかる加工方法を用いて作られるZnSe 10 光学部品は、くもり、スクラッチが無く、表面粗さも2 ~3 nmRaにすることができる。

【0009】また、この髙精度、髙品質ZnSe光学部 品を反射鏡や集光レンズとして用いたレーザ加工装置 は、集光スポット径を可及的に小さくして焦点位置での レーザ光のエネルギー密度を髙めることができ、加工の 髙速化、加工品質の向上が図れる。

[0010]

【作用】この発明では、単結晶ダイヤモンドバイトの刃 20 先を面取りして刃先の欠損を抑制する。また、刃先の面 取り幅を0.5~2μmとすることで刃先の鋭利さも維 持し、バイトの長寿命化と切味の良さを両立させる。

【0011】また、切刃のすくい角を-20度以上、2 0 度以下として切屑の排出を円滑化し、併せて刃先の強 度を髙める。

【0012】さらに、逃げ角を5~10°とすること で、創成された加工面に適度のプレッシャを与えながら 加工面とバイト逃げ面の接触を円滑化し、加工面の仕上 りを良くする。

1本のバイトによる加工量の増加が可能になる。

【0014】そこで、粗加工→(中仕上げ→)仕上げを 1本のバイトでバイト交換なしで実施し、各段階での段 取り(バイト交換、諸調整)の時間を大幅に削減する。

【0015】また、粗加工での切込み量を5μm以上と 大きくして加工時間を短縮し、一方、仕上げ加工では切 込み量を1~5μmにして高品質な仕上り精度の確保と 加工時間の短縮を実現する。

【0016】さらに、1本のバイトで2個以上の結晶材 り返すことになるので、加工時間が長くなるほか、加工 40 料を連続加工することで、バイト交換、調整、加工プロ グラム再作成などの時間短縮のほか、精密に制御された 環境の保持(加工現象変動要因の排除)、バイト品質の 個体差による影響の排除、人的ミスの排除、加工装置の 負担軽減を図る。

> 【0017】かかる方法で加工されたZnSe光学部品 は、表面に欠陥(スクラッチ、くもりなど)が無く、髙 品質であり、平面、球面、非球面と云った様々な表面形 状を用いて実現される機能が高まる。

> 【0018】また、このZnSe光学部品を用いたレー

3

より、性能及び信頼性が向上する。特に、消耗した光学 * 部品の交換に伴う加工特性の変化が生じない。

[0019]

【発明の実施の形態】図1に、この発明で用いる単結晶 ダイヤモンドバイトの刃先形状を示す。図の1は単結晶 ダイヤモンド、2はこのダイヤモンドに付された切刃、 3は切刃のエッジを除去する面取り部、4はすくい面、 5は逃げ面、6は単結晶ダイヤモンド1を支持する台金 である。台金6は必要に応じて設けられる。

1 (b) の α はすくい角、 β は逃げ角、Wは刃先の面取 り幅であり、ここではR=1. 5 mm、 $\alpha=0$ °、 $\beta=7$ °、W=0. $8\mu m$ に設定してある。

【0021】図2の8は、ホルダ7の先端に図1の刃先 形状をもつ単結晶ダイヤモンド1を止着して構成される バイトである。この発明では、この単結晶ダイヤモンド バイト8を送りかけて回転している結晶材料Aに切込ま*

加工面形状:平面

加工条件

粗加工:回転数2000rpm 、送り5mm/min 、切込み10μm

中仕上げ: " 、 " 2.5 mm/min 、 " $5 \mu m$

仕上げ: """ *, 11* $^{\prime\prime}$, $^{\prime\prime}$ 1 μ m

上の加工で得られた加工面の性状は以下の通りであっ た。

表面粗さ: 2~3 nmRa

仕上り:くもり、スクラッチともに無し

面精度: 0.5 µ m以下

【0024】-実施例2-

に引き続いて使用し、直径50mm、厚さ4mm、焦点距離 127mmの非球面ZnSeレンズの加工を行った。この 加工は、実施例1で片面の平面加工を行った2 n S e 多 結晶体について行い、その多結晶体の他面を凸非球面に 加工してレンズに仕上げたものである。加工条件は、実 施例1と同じにした。この加工で得られた凸非球面は、

表面粗さ:2~3 n m R a 面精度: 0. 5 μ m以下

波面収差: 1μm以下

であり、反対側の平面と同様、非常に品質が良かった。 40 の信頼性が向上する。 【0025】また、この実施例1、2の加工を経て得ら れた非球面ZnSeレンズは、レーザ光の集光試験で集 光スポット径がほぼ回析限界まで小さくなることが確認 された。

【0026】-実施例3-

仕上げの切込み量を1.5μmに変え、他は実施例1と 同一条件にして実施例1で加工したものと同じZnSe 多結晶体を1本のバイト(仕様は実施例1のものと同 じ)で 個加工したところ、実施例1とほぼ同じ結果が *せ、材料の外径部から中心部までのバイト送りを反復さ せ、粗加工時と仕上げ時の切込み量を変えて粗加工から 仕上げ加工までを同じ1本のバイトで行う。

【0022】また、同じバイトを用いて条件を変えずに 複数個の結晶材料を加工する。以下に、その加工の具体 例を挙げる。

【0023】-実施例1-

直径50mm、板厚5mmのZnSe多結晶体(CVD材) を5個準備し、これを、前述のノーズ半径R=1.5m 【0020】図1 (a)のRは切刃部のノーズ半径、図 10 m、すくい角 $\alpha=0$ °、逃げ角 $\beta=7$ °、刃先面取り幅 W=0.8μmの単結晶ダイヤモンドバイトで加工し た。使用したバイトは1本である。 ZnSe多結晶体 は、1個目の仕上げが完了したら2個目の未加工品と入 れ替えて1個目と同じ加工プログラムに基いて同一条件 で仕上げまでを行い、これを繰り返す方法で行った。加 工条件は以下の通りとした。

にしたときの結果もほぼ同じであった。

【0027】なお、この発明はZnSe以外の光学部品 用結晶体の加工にも有効である。

[0028]

【発明の効果】以上述べたこの発明の方法によれば、使 用するバイトの改善によりバイトの寿命が延びる。例え ば、ZnSeレンズのSPDT加工では、従来バイト使 実施例1で用いた単結晶ダイヤモンドバイトを交換せず 30 用時の加工可能枚数がバイト1本当り1枚であったのに 対し、この発明では1本のバイトで10枚以上のレンズ を加工でき、10倍以上の寿命を示した。

> 【0029】また、バイトを改善して粗加工での切込み 量を大きくしたことと、加工手順を改善して段取り変え 等を減らしたことにより加工時間も大巾に短縮される。

> 【0030】さらに、刃先強化のための面取り幅の制 限、加工面に無理なくプレッシャを与えられる逃げ角の 設定、1本のバイトによる複数個の結晶材料の連続加工 により、加工面の高精度化、高品質化も実現され、加工

【0031】このほか、工具費の削減、加工時間の削減 により、加工費も下がる。

【0032】また、この発明の方法で加工されたZnS e光学部品は、光学特性に優れ、レーザ加工装置等の性 能、信頼性を向上させる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a)この発明の方法で用いる単結晶ダイヤモ ンドバイトの刃先形状を示す平面図

- (b)同上のバイトの刃先の側面図
- 得られた。また、仕上げの切込み量を 3μ m及び 5μ m 50 【図 2 】 2 n S e 多結晶体の S P D T 加工法を示す図

5

【図3】従来法で用いていた多結晶ダイヤモンドバイト

・の刃先の側面図

【符号の説明】

- 1 単結晶ダイヤモンド
- 2 切刃
- 3 面取り部
- 4 すくい面

(a)

5 逃げ面

- 6 台金
- 7 ホルダ
- 8 単結晶ダイヤモンドバイト

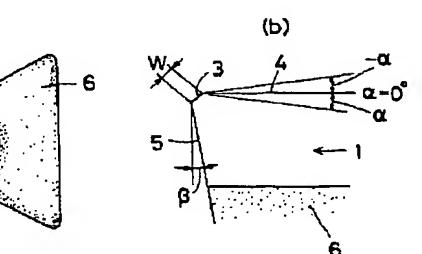
6

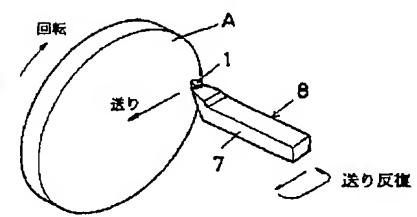
- R ノーズ半径
- α すくい角
- β 逃げ角
- W 刃先の面取り幅

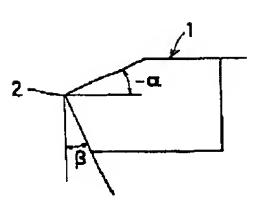
[図2]

A 結晶材料

【図1】







【図3】